



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HSBD140

对应国外型号
BD140

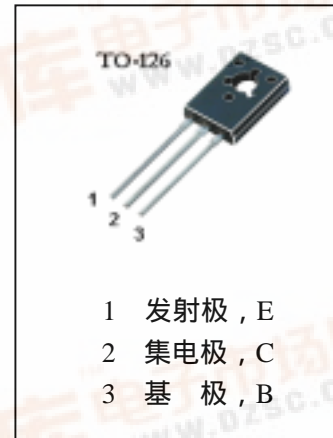
主要用途

中功率线性开关

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25$)	12.5W
P_C ——集电极功率耗散 ($T_A=25$)	1.25W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-80V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-80V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流(Pulse).....	-3A
I_C ——集电极电流(DC).....	-1.5A
I_B ——基极电流.....	-0.5A

外形图及引脚排列



- 1 发射极, E
- 2 集电极, C
- 3 基极, B

电参数 ($T_C=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{CB} = -30V, I_E = 0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-10	μA	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$
* $h_{FE(1)}$	直流电流增益(1)	25				$V_{CE} = -2V, I_C = -5mA$
* $h_{FE(2)}$	直流电流增益(2)	25				$V_{CE} = -2V, I_C = -0.5A$
* $h_{FE(3)}$	直流电流增益(3)	40		250		$V_{CE} = -2V, I_C = -150mA$
* $V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			-0.5	V	$I_C = -500mA, I_B = -50mA$
* $V_{BE(ON)}$	基极—发射极电压			-1.0	V	$I_C = -0.5A, V_{CE} = -2V$
* $V_{CEO(SUS)}$	集电极—发射极维持电压	-80			V	$I_C = -30mA, I_B = 0$

*Pulse Test: PW=350 μS , Duty Cycle=2% Pulsed

$h_{FE(3)}$ 分档及其标志

Cassification	6	10	16
	40~100	63~160	100~250

